


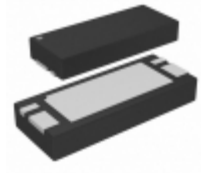
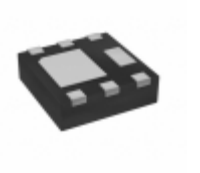
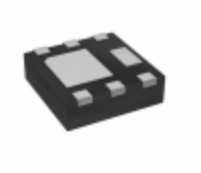

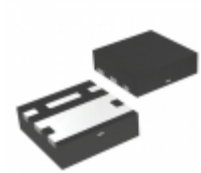

	DMN2013UFDE-7	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN2013UFDE-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 20V 10.5A U-DFN
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 DMN2013UFDE-7.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 21000 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DMN2013UFDE-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 10.5A U-DFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	21000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-UDFN Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	U-DFN2020-6 (Type E)
Verlustleistung (max)	660mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 8.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25.8nC @ 8V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2453pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































DMN2013UFDE-7 ist neu im Original, Suche DMN2013UFDE-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN2013UFDE-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN2013UFDE-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN2013UFX-7 Displaytech MOSFET 2N-CH 20V 10A 6-DFN</p>	 <p>DMN2011UFX-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 12.2A DFN2050-4</p>	 <p>DMN2011UFDF-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 14.2A UDFN2020-6</p>	 <p>DMN2011UFDF-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 14.2A UDFN2020-6</p>
 <p>DMN2013UFDEQ-7 DIODES DMN2013UFDEQ-7 DIODES</p>	 <p>DMN2011UFDE-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 11.7A UDFN2020-6</p>	 <p>DMN2015UFDE-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 10.5A U-DFN</p>	 <p>DMN2011UTS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 21A 8-TSSOP</p>

heiße Teile

Mehr

 DMN13H1750S-7	 DMN13H750S-7	 DMN15H310SE-13	 DMN2004DMK	 DMN2004DMK-7
 DMN2004DWK-7	 DMN2004DWK-7-F	 DMN2004K-7	 DMN2004K-7-F	 DMN2004TK-7
 DMN2004TK-7-F	 DMN2004VK	 DMN2004VK-7	 DMN2004VK-7-G	 DMN2004WK-7
 DMN2004WKQ-7	 DMN2005DLP4K-7	 DMN2005K-7	 DMN2005K-7-F	 DMN2005LP4K-7
 DMN2005LPK-7	 DMN2009LSS	 DMN2009LSS-13	 DMN2009LSS-13-F	 DMN2011UFX-7
 DMN2013UFDEQ-7	 DMN2015UFDE-7	 DMN2015UFDE.TCT	 DMN2016LFG-7	 DMN2016LHAB-7
 DMN2016UTS-13	 DMN2017UFDE-7	 DMN2019UTS-13	 DMN2020LSN	 DMN2020LSN-7
 DMN2020LSN-7-F	 DMN2020UFCL-7	 DMN2023LSD-13	 DMN2026UVT-7	 DMN2027LK3-13
 DMN2027USS	 DMN2027USS-13	 DMN2027USS-13-F	 DMN2028UFDH-7	 DMN2028USS
 DMN2028USS-13	 DMN2028USS-13-F	 DMN2028UVT-7	 DMN2029USD	 DMN2029USD-13

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited